



**Characteristics****Kennwerte**

		(T <sub>j</sub> = 25°C)	Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>					
I <sub>C</sub> = 10 mA, I <sub>B</sub> = 1 mA	V <sub>CEsat</sub>		–	–	0.2 V
I <sub>C</sub> = 50 mA, I <sub>B</sub> = 5 mA			–	–	0.3 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>					
I <sub>C</sub> = 10 mA, I <sub>B</sub> = 1 mA	V <sub>BEsat</sub>		0.65 V	–	0.85 V
I <sub>C</sub> = 50 mA, I <sub>B</sub> = 5 mA			–	–	0.95 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
V <sub>CE</sub> = 30 V, V <sub>EB</sub> = 3 V	I <sub>CBX</sub>		–	–	50 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
V <sub>CE</sub> = 30 V, - V <sub>EB</sub> = 3 V	I <sub>EBV</sub>		–	–	50 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
I <sub>C</sub> = 10 mA, V <sub>CE</sub> = 20 V, f = 100 MHz	f <sub>T</sub>		300 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
V <sub>CB</sub> = 5 V, I <sub>E</sub> = i <sub>e</sub> = 0, f = 1 MHz	C <sub>CB0</sub>		–	–	4 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität					
V <sub>EB</sub> = 0.5 V, I <sub>C</sub> = i <sub>c</sub> = 0, f = 1 MHz	C <sub>EBO</sub>		–	–	8 pf
Switching times – Schaltzeiten (between 10% and 90% levels)					
delay time	V <sub>CC</sub> = 3 V, V <sub>BE</sub> = 0.5 V I <sub>C</sub> = 10 mA, I <sub>B1</sub> = 1 mA	t <sub>d</sub>	–	–	35 ns
rise time		t <sub>r</sub>	–	–	35 ns
storage time	V <sub>CC</sub> = 3 V, I <sub>C</sub> = 10 mA, I <sub>B1</sub> = I <sub>B2</sub> = 1 mA	t <sub>s</sub>	–	–	200 ns
fall time		t <sub>f</sub>	–	–	50 ns
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R <sub>thA</sub>	357 K/W <sup>2)</sup>		

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses t<sub>p</sub> = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t<sub>p</sub> = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%  
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature  
 Gültig, wenn die Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [Diotec manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NTE158](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE63](#) [C4460](#)  
[2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2369ADCSM](#)  
[2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC5490A-TL-H](#) [2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)  
[US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CMXT3906 TR](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)  
[NJL0302DG](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3583](#) [NTE103](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE101](#) [NTE13](#) [NTE15](#) [NTE16001](#) [NTE16006](#)  
[NTE26](#)